

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 02-222533

(43)Date of publication of application : 05.09.1990

(51)Int.Cl. H01L 21/304
B24B 7/20
B24B 49/12

(21)Application number : 01-044653 (71)Applicant : SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

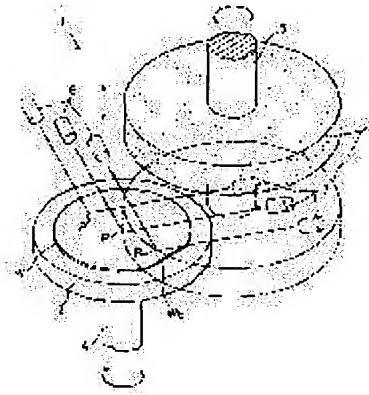
(22)Date of filing : 23.02.1989 (72)Inventor : NISHIGUCHI KATSUNORI
GOTO NOBORU

(54) POLISHING DEVICE FOR SEMICONDUCTOR WAFER

(57)Abstract:

PURPOSE: To cut down the time required for the measurement thereby enabling the time for the whole polishing process to be cut down by a method wherein the title polishing device of semiconductor wafer is provided with an illuminating device capable of irradiating the polished surface of the semiconductor wafer, a photodetector capable of detecting the reflected light quantity and a control means deciding the termination or continuation of the polishing work conforming to the results of measurement by the photodetector.

CONSTITUTION: The title polishing device 1 of semiconductor wafer capable of measuring the roughness of a polished surface of the semiconductor wafer W and deciding the termination or continuation of the polishing work conforming to the results of measurement is provided with an illuminating device capable of irradiating the polished surface of the semiconductor wafer W mounted on a polishing stage 2, a photodetector capable of detecting the reflected light quantity and a control means deciding the termination or continuation of the polishing work conforming to the results of measurement by the photodetector. For example, illuminating elements 6 comprising the illuminating device and photodetecting elements 7 comprising the photodetector are provided so that the surface



of the semiconductor wafer W i.e., the measurement points P on the polished surface may be irradiated with the light focussed from the illuminating elements 6 through the projecting lens to detect the reflected light from the measurement points P on the photodetecting surfaces of the photodetecting elements 7 through the photodetecting lens.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑪ 公開特許公報 (A) 平2-222533

⑤Int.Cl.⁵
H 01 L 21/304
B 24 B 7/20
49/12

識別記号 331
府内整理番号 8831-5F
8813-3C
7908-3C

⑪公開 平成2年(1990)9月5日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

⑫発明の名称 半導体ウェーハの研削装置

⑬特 願 平1-44653
⑭出 願 平1(1989)2月23日

⑮発明者 西 口 勝 規 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社
横浜製作所内
⑯発明者 後 藤 登 神奈川県横浜市栄区田谷町1番地 住友電気工業株式会社
横浜製作所内
⑰出願人 住友電気工業株式会社 大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号
⑱代理人 弁理士 長谷川 芳樹 外3名

明細書

1. 発明の名称

半導体ウェーハの研削装置

2. 特許請求の範囲

半導体ウェーハの研削仕上げ面の面粗さを測定し、この測定結果に基づいて研削作業の終了又は続行を決定する半導体ウェーハの研削装置において、

研削ステージ上に載置した半導体ウェーハの研削仕上げ面に光を照射可能な発光器と、この光の反射光量を検出可能な受光器と、受光器の検出結果に基づいて研削作業の終了又は続行を決定する制御手段とを備えたことを特徴とする半導体ウェーハの研削装置。

3. 発明の詳細な説明

(産業上の利用分野)

本発明は、主としてGaAs半導体ウェーハの

研削仕上げ面の面粗さを測定して、研削作業の終了又は続行を決定する半導体ウェーハの研削装置に関する。

〔従来の技術〕

各種処理工程を経て回路パターン等が(100)面に形成された半導体ウェーハは、ダイシング工程の前に実装用の厚さに研削される。その際裏面の(100)面が研削されるが、この(100)面は後のダイボンディング工程で所定のダイボンディング強度を必要とすることから所定の面粗さを要求される。しかし、この仕上げ面は、研削時における砥石表面の砥粒の状態により変化を受け易く、半導体ウェーハを連続して安定に研削するのは難しい。このため、従来は半導体ウェーハの仕上げ状態を確認すべく、その都度研削テーブルから取外して面粗さを測定するようしている。そして、所定の面粗さの基準値を満たせば研削作業の終了して次の半導体ウェーハの研削を実行し、満たさない場合には半導体ウェーハを研削テーブルに再度セットして研削作業を続行するようにし

ている。

【発明が解決しようとする課題】

このように従来の研削装置にあっては、面粗さを測定する場合に半導体ウェーハをその都度研削テーブルから取外さねばならないため、研削工程全体に要する時間が長くなる不具合があった。

本発明は、測定に要する時間を短縮して研削工程全体の時間短縮を図る半導体ウェーハの研削装置を提供することをその目的とする。

【課題を解決するための手段】

本発明は上記目的を達成すべく、半導体ウェーハの研削仕上げ面の面粗さを測定し、この測定結果に基づいて研削作業の終了又は続行を決定する半導体ウェーハの研削装置において、研削ステージ上に載置した半導体ウェーハの研削仕上げ面に光を照射可能な発光器と、この光の反射光量を検出可能な受光器と、受光器の検出結果に基づいて研削作業の終了又は続行を決定する制御手段とを備えたことを特徴とする。

【作用】

発光器により半導体ウェーハの研削仕上げ面の任意の点に光を照射し、この光の反射光量を受光器で検出する。このとき受光量が一定量以上あれば研削仕上げ面が所定の平滑さに仕上がっていようと判断でき、一定量以下あれば所定の平滑さに仕上がっていないと判断できる。

このように研削装置に光学的に面粗さを測定可能な発光器と受光器とを備えることにより、従来のように半導体ウェーハを研削ステージから取外すことなくその研削仕上げ面の測定を行うことができ、制御手段を備えることにより、直ちに研削作業の終了又は続行を決定できる。

【実施例】

第1図を参照して本発明を実施したGaAs半導体ウェーハの研削装置について説明する。

この研削装置1は、各種処理工程を経た後の半導体ウェーハWをダイシング工程の前に実装用の厚さに研削するもので、半導体ウェーハWを吸着により載置固定する研削ステージ2と、その上方

に半導体ウェーハWを研削する研削砥石3とを備えている。研削ステージ2は、回転軸4に連結された駆動装置(図示せず)により半導体ウェーハWを吸着した状態で回転し、また研削砥石3は、駆動軸5に連結された駆動装置(図示せず)により回転しながら昇降動する。したがって、半導体ウェーハWは研削の際に自らゆっくり回転すると共に、回転しながら徐々に下降してくる研削砥石3により、その研削仕上げ面である(100)面が均一に研削される。

また、研削ステージ2上には、図示しない固定部材により発光器を構成する発光素子6と受光器を構成する受光素子7とが設けられており、この発光素子6から半導体ウェーハWの表面、すなわち研削仕上げ面の測定点Pに投光レンズを介して集光された光が照射され、測定点Pからの反射光は受光レンズを介して受光素子7の受光面で受光される。そして、この反射光の光量の多少により研削仕上げ面の面粗さが測定される。

また、発光素子6と受光素子7とは、少なくと

も3箇所の測定点Pを測定するため、移動装置(図示せず)により相対的に移動できるように構成されている。測定点Pは、GaAs半導体ウェーハWが結晶の異方性によって第2図の斜線で示した扇状領域Wa、Waで面粗さが悪化しやすいこと、及びウェーハも回転させるこの種の研削方式では、ウェーハの中心部分の面粗さが悪化しやすいことに鑑みて、半導体ウェーハWの中心点と、半導体ウェーハWのオリエンテーションフラットWaに直交する中心線上の中心点を挟んだ径方向の2箇所の合計3箇所とした。

そして、この3箇所の測定値のすべてが基準値を満たせば研削を終了し、1箇所でも基準値を満たさない箇所がある場合には再研削を行う。

これを第3図に示すように具体的に研削装置1の制御と関連させて説明する。発光器は、発光素子駆動回路8と発光素子6とから構成され、研削砥石3の上昇完了を検知した発光素子駆動回路8の信号により、研削ステージ2を回転させた状態で発光素子6から点灯駆動により各測定点Pに順

次に光が照射される。一方、受光器は受光量検出器9と受光素子7とから構成されており、各測定点Pからの反射光が受光素子7により受光され、続く受光量検出器9で反射光量が検出される。受光量検出器9はすべての測定点で反射光量が所定の値に達している場合には終了コントローラ10に信号を送り、いずれか1箇所でも反射光量が所定の値に達しない場合には続行コントローラ11に信号を送る。終了コントローラ10はこの信号により移載装置駆動部12を制御して、研削を完了した半導体ウェーハWを抜出し、新たな半導体ウェーハWを研削ステージ2上にセットする。一方、続行コントローラ11はこの信号により研削砥石駆動部13を制御し、研削作業を続行する。

以上のように構成すれば、半導体ウェーハWを、研削ステージ2上にセットした状態で測定できると共に、発光素子6を点灯駆動させることより研削ステージ2を回転させた状態で測定することができ、同時に研削作業の終了又は続行へ瞬時に移行することができる。

【発明の効果】

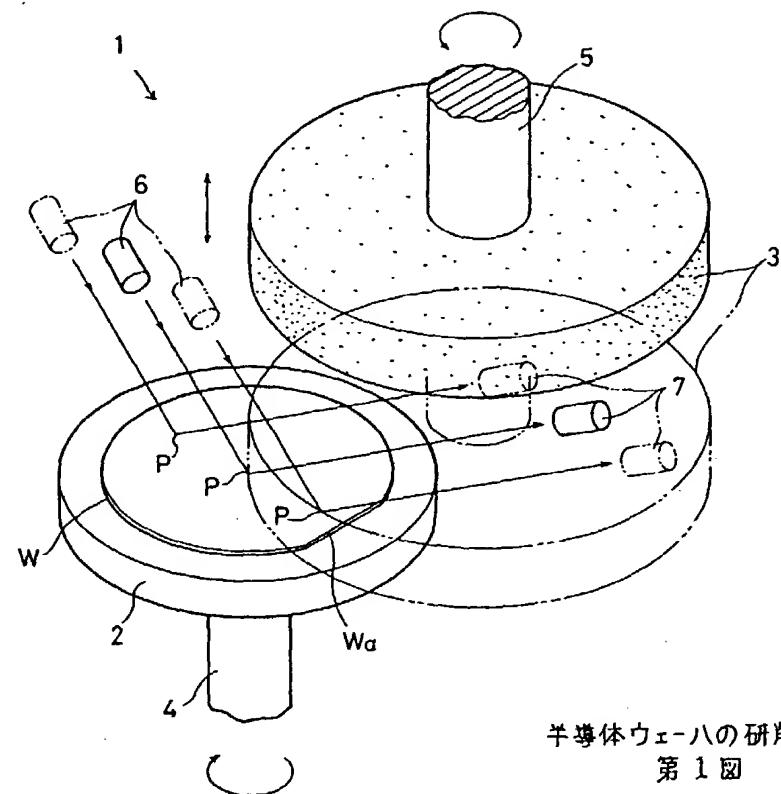
以上のように本発明によれば、半導体ウェーハの面粗さを研削ステージに設置した状態で測定できるため、研削工程に要する時間が短縮でき、しかも、従来のように半導体ウェーハを研削ステージからの着脱する際に誤って破損することも防止でき、生産性を向上し得る効果を有する。

4. 図面の簡単な説明

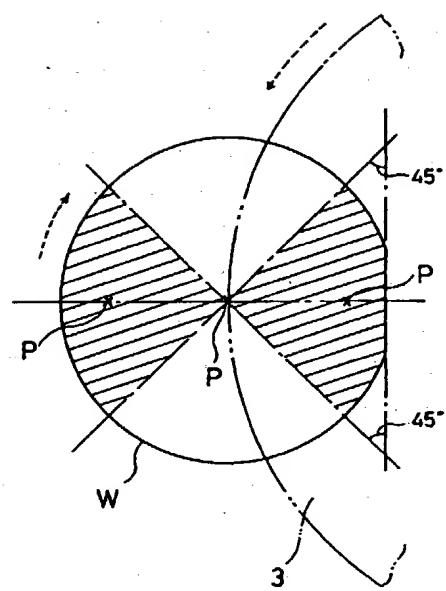
第1図は本発明を実施した半導体ウェーハの研削装置の概略図、第2図は測定点を示した半導体ウェーハの平面図、第3図は面粗さ測定の制御フロー図である。

1…研削装置、2…研削ステージ、6…発光素子、7…受光素子、8…発光素子駆動回路、9…受光量検出器、10…終了コントローラ、11…続行コントローラ、W…半導体ウェーハ。

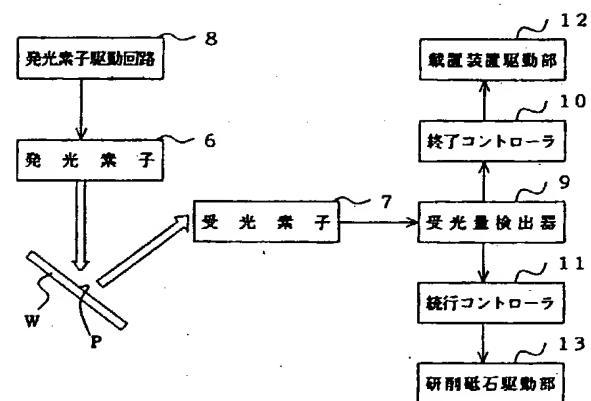
特許出願人 住友電気工業株式会社
代理人弁理士 長谷川 芳樹



半導体ウェーハの研削装置
第1図



半導体ウエーハの(100)面
第2図



面粗さ測定の制御フロー

第3図